
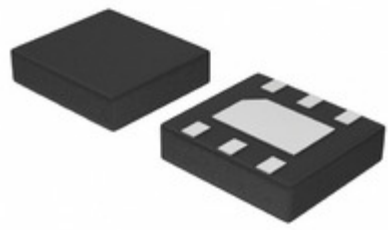
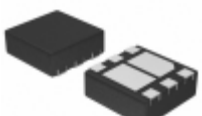

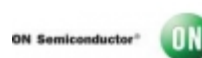


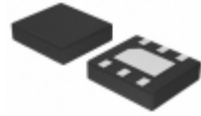
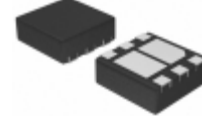

	<h2>NTLGD3502NT2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTLGD3502NT2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN</p> <p>Datenblätter:  NTLGD3502NT2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29224 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTLGD3502NT2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29224 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.74W
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-DFN (3x3)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A, 3.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLGD3502NT2G ist neu im Original. Suche NTLGD3502NT2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLGD3502NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLGD3502NT2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTLJD2104PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p>NTLGF3501NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p>	 <p>NTL4502NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 24V 11.4A 16PIN</p>	 <p>NTLGF3402PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>
 <p>NTLGF3402PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>	 <p>NTLGD3502NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN</p>	 <p>NTLJD2104PTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p>NTLJ3113PT1G ON NTLJ3113PT1G ON</p>

heiße Teile

Mehr

1808HA330KAT1A	AAT2842IBJ-EE-T1	ADM1069ASTZ-REEL7	AH180-PG-A	ALC1006-CG
AT91SAM7SE256-AU	BAR63-05E6327	BC847BST1	CAT6095VP2-GT4	CYUSB3610-68LTXC
IR2004STRPBF.	MP2301ENE-C259-LF-Z	NTLGD3502NT1G	NTLJ3113PT1G	NTLJD2105LTBG
NTLJD3115PT1G	NTLJD3115PTAG	NTLJD3119CT1G	NTLJD3119CTAG	NTLJD3119CTBG
NTLJD4116NT1G	NTLJF3117PT1G	NTLJF4156NT1G	NTLJF4156NTAG	NTLJS2103P
NTLJS2103PTAG	NTLJS2103PTBG	NTLJS3113P	NTLJS3113PT1G	NTLJS3113PTAG
NTLJS3A18PZTWG	NTLJS4114NT1G	NTLJS4114NTAG	NTLLD4901NF	NTLLD4901NFTWG
NTLTD7900NR2G	NTLTD7900ZR2	NTLTD7900ZR2G	NTLUD3A260PZTAG	NTLUD3A50PZTAG
NTLUF4189NZTAG	NTLUS3A18PZTAG	NTLUS3A40PZTAG	NTLUS3A40PZTBG	NTLUS3A90PZTAG
NTLUS4930NTAG	OPA2244UA/2K5	RS8228EBG	S1D-M3/61T	S9S08DZ96F2CLHR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited